

تحلیل اثر تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی بر مشخصه‌های استاتیکی لیزرهای نقطه InAs/InP کوانتومی

غلامرضا باباعباسی^۱، علی میر^۲ و محمدحسن یآوری^۳

۱- موسسه آموزش عالی شهاب دانش، گروه الکترونیک

۲- دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه الکترونیک

۳- دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه الکترونیک

چکیده - در این تحقیق رفتار لیزرهای نقطه کوانتومی خودآرای InAs/InP در طول موج ۱/۵۵ میکرومتر با در نظر گرفتن حالت پایه و برانگیخته و لحاظ کردن اثرات پهن شدگی همگن و غیر همگن بهره با استفاده از حل معادله نرخ لیزر مدل سازی می شود. شبیه سازی ها نشان می دهد با افزایش جریان تزریقی وقتی کانال واهلش مستقیم از تراز وتینگ به تراز پایه در نظر گرفته می شود، اثر اشباع حالت پایه دیده نمی شود، همچنین لیزردهی حالت برانگیخته در طول موج ۱/۴۲ میکرو متر ظاهر می شود. علاوه بر این، افزایش تعداد لایه های نقطه کوانتومی باعث افزایش کارایی کوانتومی شده، ولی متاسفانه افزایش جریان آستانه را در پی دارد.

کلید واژه- بهره نوری، پهن شدگی غیر همگن، لیزر نقطه کوانتومی، معادله نرخ.

Analysis of Effect of Number of Quantum Dot Layers on Static Characteristics InAs/InP Quantum Dot Laser

Gholamreza Babaabasi¹, Ali Mir², and Mohammad-Hasan Yavari³

1- Shahab Danesh Institute of Higher Education

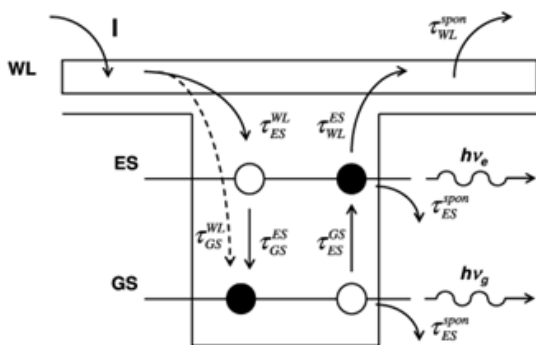
2- Lorestan University, Dept. of Engineering

3- Shahed University, Dept. of Engineering

Abstract- In this paper the behavior of InAs/InP quantum dot semiconductor lasers in 1.55 μm by considering excited and ground state and effects gain homogeneous broadening and inhomogeneous broadening will be simulate by implementing rate equations. The simulation results indicates increasing in injected current when direct relaxation channel between wetting state and ground state is considered, there is no effect of ground state saturation. In addition, the excited state lasing will appear in 1.42 μm . in the following, by examining the number of quantum dot layers, the quantum efficiency will enhance by increase in quantum dot layers but the threshold current will increase too.

Keywords: Gain optical, Inhomogeneous broadening, Quantum dot laser, Rate equations.

۱- مقدمه



شکل ۱: مدل دینامیک حامل‌ها با کانال واهلش مستقیم (خط چین) و آبشاری برای n امین گروه نقطه کوانتومی

۱-۲- معادلات نرخ توصیف کننده دینامیک

حامل و فوتون‌ها

از نوشتن معادلات نرخ برای چگالی تراز ویتینگ، ترازهای تحریک و زمین گروه‌های نقاط کوانتومی و نیز فوتون‌ها صرف‌نظر می‌کنیم و صرفاً به معادلات بهره‌های نوری خطی و احتمال اشغال حالت‌ها که وابسته به ساختار فوتونیک کریستال خواهد شد اکتفا می‌کنیم. برای دیدن این معادلات می‌توان به [۶] مراجعه کرد.

۲- معادلات نرخ حامل و فوتون

برای تحلیل رفتار لیزر دو تراز پایین‌تر انرژی به عنوان حالت پایه و حالت برانگیخته در سیستم InAs/InP استفاده شده است و از وجود حالت پیوستار انرژی چشم پوشی شده است. الکترون و حفره را بصورت زوج الکترون و حفره در نظر می‌گیریم. شکل (۱) دیگرام انرژی نوار هدایت ناحیه فعال لیزر نقطه کوانتومی و فرآیند واهلش حامل‌ها را نشان می‌دهد. حامل‌ها به درون لایه ویتینگ با آهنگ جریان تزریقی I واهلش می‌یابند. این لایه مانند مخزنی برای ترازهای پائین‌تر عمل می‌کند. حامل‌ها از WL به داخل تراز برانگیخته یا به‌طور مستقیم به داخل تراز پایه GS با ثابت زمانی $\tau_{ESn}^{WL} = \tau_{GSn}^{WL}$ واهلش می‌یابند. در تراز ES تعدادی از جفت الکترون حفره‌ها با ثابت زمانی τ_{spon} به‌طور خودبخودی باز ترکیب می‌شوند و تعدادی به درون حالت پایه با ثابت زمانی τ_{GSn}^{WL} واهلش می‌یابند [۳-۱].

$$g_{mnES} = \mu_{ES} \frac{\pi e^2 \hbar}{c n_r \epsilon_0 m_0^2} \frac{N_d}{H} \frac{|P_{ESn}^\sigma|^2}{E_{ESn}} \quad (1)$$

$$\times (2P_{ESn} - 1) G_{nES} B_{ES} (E_m - E_{ESn})$$

$$g_{mnGS} = \mu_{GS} \frac{\pi e^2 \hbar}{c n_r \epsilon_0 m_0^2} \frac{N_d}{H} \frac{|P_{GSn}^\sigma|^2}{E_{GSn}} \quad (2)$$

$$\times (2P_{GSn} - 1) G_{nGS} B_{GS} (E_m - E_{GSn})$$

$$P_{ESn,GSn} = \frac{N_{ESn,GSn}}{\mu_{ES,GS} N_d W L_{ca} N_l G_{nES,nGS}} \quad (3)$$

$$P_m = c E_m S_m \ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right) / (2 n_r L c a v) \quad (4)$$

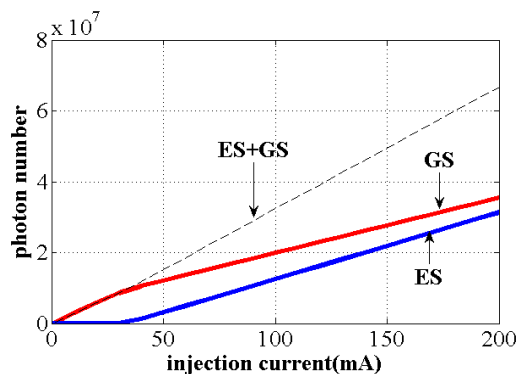
در این معادلات بهره نوری خطی g_{mn} به احتمال اشغال حالت‌های $P_{ESn,GSn}$ وابسته است و احتمال اشغال حالت‌های $P_{ESn,GSn}$ به تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی N_L وابسته است. توان خروجی برای فوتون‌های مد m بصورت رابطه (۴) است. در ادامه معادله نرخ را به روشی رانک کوتای مرتبه چهار با اعمال جریان پله واحد در زمان $t = 0$ حل می‌کنیم و برای بررسی رفتار استاتیک زمانی نوسانات واهلش مدهای لیزش به اتمام می‌رسد مقدار چگالی

فوتون‌ها در هر یک از مدهای همراه با طول موج گذار بین بانندی مد مربوطه را در نظر می‌گیریم.

۳- لیزردهی دو حالت

نتایج عملی لیزرهای نیمه‌های (۱۱۳) InAs/InP نشان می‌دهد که با افزایش جریان تزریقی دومین پیک لیزری در طیف لیزر دهی ظاهر می‌شود [۴]. در مدل آشناری وقتی که تراز برانگیخته به آستانه لیزش می‌رسد گسیل از تراز پایه اشباع می‌گردد و گسیل از تراز برانگیخته بطور خطی افزایش می‌یابد این حالت در مقاله [۵] بررسی گشته است. در لیزری که در این مقاله مد نظر است مبتنی بر کانال واهلش مستقیم از لایه وتینگ به تراز پایه است که در این حالت برخلاف واهلش آشناری گسیل از تراز پایه هیچ وقت اشباع نمی‌شود.

شکل (۲) چگالی فوتونهای گسیلی محاسبه شده در ناحیه فعال لیزر به ازای کانال واهلش مستقیم از تراز وتینگ به تراز پایه به ازای $\Gamma_0 = 30\text{meV}$, $L_{cav} = 0.7\text{mm}$ و $w = 30\mu\text{m}$, $\Gamma_{\text{hom,GS}} = 20\text{meV}$, $\Gamma_{\text{hom,ES}} = 20\text{meV}$ تابعی از جریان تزریقی برای ترازهای پایه و برانگیخته را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن مدل کانال واهلش مستقیم دو مقدار آستانه برای دو گسیل لیزری نشان داده شده است وقتی گسیل القایی حالت برانگیخته ظاهر می‌شود کارایی کوانتومی (شیب) برای نمودار حالت پایه کاهش می‌یابد و در همان نقطه گسیل القایی حالت برانگیخته افزایش می‌یابد.

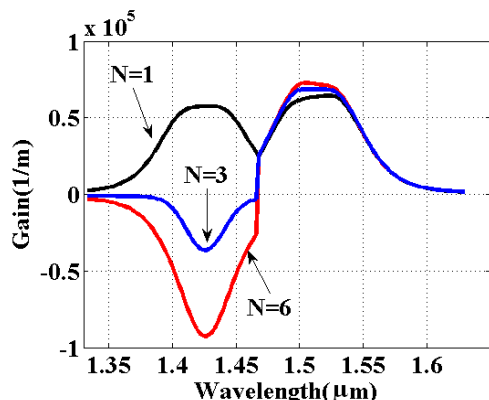


شکل ۲: چگالی فوتون‌ها بر حسب جریان تزریقی برای لیزر دو حالت

۴- تاثیر تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی بر طیف بهره

در شکل (۳) طیف بهره برای تعداد متفاوت لایه نقطه کوانتومی به‌ازای $\Gamma_{\text{hom,ES}} = 15\text{meV}$ $\Gamma_{\text{hom,GS}} = 10\text{meV}$ و جریان ۱۰ mA شبیه‌سازی شده است. به ازای یک لایه

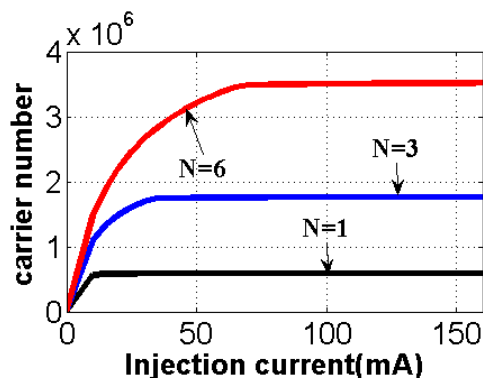
نقطه کوانتومی، بهره برای هر دو تراز پایه و برانگیخته مثبت است و توان خروجی در این حالت ناشی از گسیل القایی است. به ازای ۳ و ۶ لایه نقطه کوانتومی تعداد نقاط یا چگالی حالت‌ها افزایش می‌یابد، که در این حالت بهره در تراز برانگیخته منفی می‌شود و لیزش در آن ناشی از گسیل خودبخودی است.



شکل ۳: طیف بهره به ازای ۳، ۶ و ۱ لایه نقطه کوانتومی

۵- بررسی اثر تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی بر جریان آستانه

شکل‌های (۴) و (۶) تغییرات توان خروجی بر حسب جریان تزریقی را برای ۱ و ۳ و ۶ لایه نقطه کوانتومی به ترتیب برای حالت پایه و حالت برانگیخته ترسیم می‌کند. شکل‌های (۵) و (۷) تغییرات چگالی حامل‌ها بر حسب جریان تزریقی را برای ۱، ۳ و ۶ لایه نقطه کوانتومی به ترتیب برای حالت پایه و حالت برانگیخته ترسیم می‌کند. با افزایش تعداد لایه‌ها احتمال شکار حامل‌ها توسط نقاط افزایش می‌یابد و این فرآیند باعث افزایش کارایی کوانتومی می‌گردد ولی در عوض با افزایش تعداد لایه‌ها که باعث افزایش تعداد نقاط یا افزایش چگالی حالت می‌گردد و به دنبال آن به جریان بیشتر برای گسیل القای نیاز دارد. بر همین اساس با توجه به شکل در حالتی که ۶ لایه نقطه کوانتومی داریم کارایی کوانتومی افزایش می‌یابد ولی جریان آستانه هم افزایش می‌یابد. در این حالت لازم است مصالحه‌ای بین جریان آستانه و کارایی کوانتومی در نظر گرفته شود. مرز گسیل القایی و برانگیخته در حالتی اتفاق می‌افتد که چگالی حامل‌ها محدود یا اشباع گردد، از مقایسه شکل‌های (۵) و (۷) می‌توان نتیجه گرفت که چگالی حامل‌های آستانه برای تراز برانگیخته بیشتر از حالت پایه است و دلیل این امر این است که تبهگنی حالت برانگیخته دو برابر حالت پایه در نظر گرفته شده



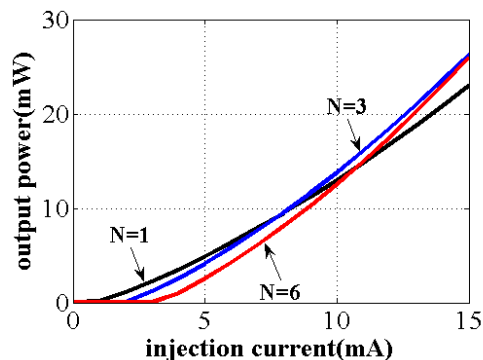
شکل ۷: تغییرات چگالی حامل‌ها برحسب جریان به ازای تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی متفاوت برای حالت برانگیخته

نتیجه‌گیری

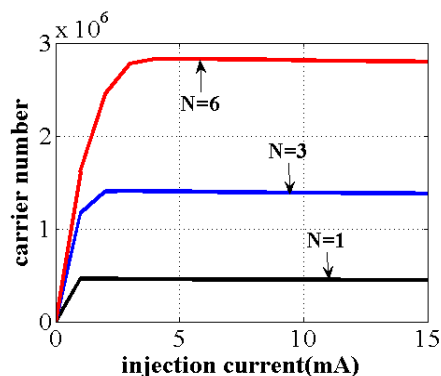
یک مدل تئوری برای بررسی ویژگی‌های طیف گسیل لیزرهای نقطه کوانتومی InAs/InP در جهت رشد (۱۱۳) در ۱/۵ میکرومتر مورد استفاده قرار گرفت. این مدل تئوری مبتنی بر حل معادلات آهنگ به روش رانک کوتای مرتبه چهار است. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش جریان تزریقی وقتی کانال واهلش مستقیم از لایه وتینگ به حالت پایه در نظر گرفته می‌شود، اثری از اشباع چگالی حامل‌ها در حالت پایه دیده نمی‌شود و با افزایش جریان تزریقی لیزردهی حالت برانگیخته در طول موج ۱/۴۲ میکرومتر ظاهر می‌گردد. شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با افزایش تعداد لایه‌های نقاط کوانتومی باعث افزایش جریان آستانه ولی در عوض باعث افزایش کارایی کوانتومی می‌گردد که لازم است مصالحه‌ای بین افزایش جریان آستانه و کارایی کوانتومی صورت بگیرد.

مراجع

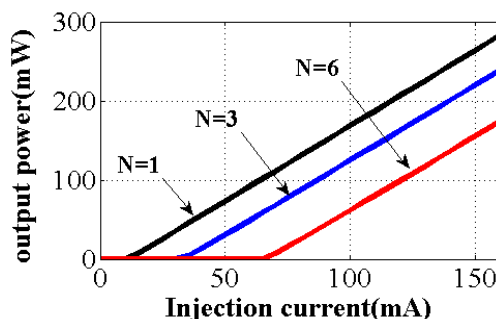
- [۱] Sugawara M, Hatori N, Ebe H, Ishida M. Modeling room temperature lasingspectra of ۱,۳ mm self-assembled InAs/GaAs quantum dot lasers: homogeneous broadening of optical gain under current injection. Journal of Applied Physics ۲۰۰۵; ۹۷: ۴۳۵۲۲-۴۳۵۲۷.
- [۲] K.Veselinov and F.Grillot; "Modelling of the two-state lasing and turn-on delay in ۱,۵۵ μm InAs/InP(۱۱۳) QD lasers"; IEEE Proc. Optoelectronic, Vol. ۱۵۳, No. ۶, December (۲۰۰۶)
- [۳] K.Veselinov and F.Grillot; "Analysis of the double laser emission in ۱,۵۵ μm InAs/InP quantum dot lasers"; IEEE, Quantum Electronic, vol. ۴۳, No. ۹, (۲۰۰۷)
- [۴] C. Platz, C. Paranthoen, P. Caroff, N. Bertru, C. Labbe, J. Even, O. Dehaese, H. Folliot, A. Le Corre, S. Loualiche, G. Moreau, J. C. Simon, and A. Ramdane, "Comparison of InAs quantum dot lasers emitting at ۱,۵۵ m under optical and electrical injection," Semicond. Sci. Technol., vol. ۲۰, pp. ۴۵۹-۴۶۳, ۲۰۰۵.
- [۵] K.Mukai, and M.Sugawara; IEEE Photon Technol.lett., (۱۹۹۹).
- [۶] «مدل سازی و بهینه سازی لیزرهای کواک کریستال فوتونی با ساختار نقطه کوانتومی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، غلامرضا باباعباسی



شکل ۴: تغییرات توان خروجی برحسب جریان به ازای تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی متفاوت برای حالت پایه



شکل ۵: تغییرات چگالی حامل‌ها برحسب جریان به ازای تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی متفاوت برای حالت پایه



شکل ۶: تغییرات توان خروجی برحسب جریان به ازای تعداد لایه‌های نقطه کوانتومی متفاوت برای حالت برانگیخته